微波谐振腔测量气体激光器电子密度

Abstract: Electron densities in CO₂ laser, CO laser and discharge of various kinds of gases such as CO₂, N₂, and He, have been measured with microwave cavity.

The dependence of electron density, gas pressure, gas composition, discharge current and E/P have been studied

一、基本原理

微波谐振腔方法广泛地用来测量气体激光器的 电子密度[1~4]。当等离子体置入微波腔后,由于放 电等离子体对微波腔频率的微扰,引起谐振腔共振 频率漂移及Q值变化,而频率漂移及Q值变化,又与 等离子体的电子密度及空间分布、电子瞬间跃迁碰 撞频率和它的空间分布等参数密切相关。

由一级微扰理论,共振腔频率漂移 Δω 与具有电 导σ的等离子体的关系如下[5]:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = \frac{j}{2\omega \varepsilon_0} \left(\int \sigma E_0^2 dv \right) / \int E_0^2 dv \right)$$
(1)

式中Eo为不存在微扰时的微波电场: Eo为介电常 数; ω为不存在微扰时的共振频率: Δω为频率漂 移。积分是沿着腔体进行的。

对于不同的模式, 计算公式也不尽相同。我们 的微波腔场型为 TMo13, 腔半径 2.8 厘米, 放电管直 径1厘米。在这种模式下,实验腔的频率漂移公式 为[5].

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = \frac{x_{0m}(R/a)^2}{2(k_0 a)^2 J_1^2(x_{0m})} (1 - k_{zz}) + \cdots$$
 (2)

加号后面的项,实际上是一个衰减项,在一级近似 下,可忽略不计。式中

$$k_{zz}=1-\alpha^2/(1-jr)$$

其中

频率。当

 $\alpha^2 = \frac{\omega_P^2}{\omega^2}; \qquad r = \frac{\nu_c}{\omega}$ 其中ν。为瞬间跃迁电子的碰撞频率; ω为共振腔角

$$\frac{\nu_{\rm c}}{\omega} \ll 1$$

时, k_{zz} 可以写成 $k_{zz} = 1 - \alpha^2$ 。

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = \frac{x_{0m}(R/a)^2}{2(k_0 a)^2 J_1^2(x_{0m})} \cdot \frac{\omega_o^2}{\omega^2}$$
(3)

式中R为激光器放电管半径; a 为谐振腔半径, xom 为零阶贝塞尔函数 $J_0(x_{0m}) = 0$ 的第m个根; $J_1(x_{0m})$

是 x_{0m} 的一阶贝塞尔函数; $k_0 = \frac{\omega}{c}$; ω_p 为等离子体 振荡频率: c 为光速。 从(3)式可得:

$$\omega_p^2 = \frac{J_1^2(x_{0m})}{x_{0m}(R/a)^2} \frac{32\pi^4 a^2}{c^2} \Delta f f^3 \tag{4}$$

代入具体数据后,得到等离子体的振荡频率为:

$$\omega_p^2 = 1.005 \times 10^{-16} \varDelta f \cdot f^3 \tag{5}$$

式(5)中, Af 就是我们从波长计中得到的等离 子体对微波谐振腔微扰时所产生的频率漂移。f是 从波长计中得到的不存在微扰时的谐振腔频率。

等离子体振荡频率与电子密度有如下关系[6]

$$\omega_p^2 = n_e e^2 / m \,\varepsilon_0 \tag{6}$$

式中e为电子电荷; m为电子质量; ne为电子密 度。

在 CGSE 单位制中:

$$\frac{\omega_p}{2\pi} = 8.98 \times 10^3 n_e^{1/2} \tag{7}$$

由(7)式得:

$$n_{e} = \frac{\omega_{p}^{2}}{(8.98 \times 10^{3})^{2} \times (2\pi)^{2}} \omega_{p}^{2} = 3.14 \times 10^{-10} \omega_{p}^{2}$$

由(5)式得:

$$n_e = 3.16 \times 10^{-26} \Delta f \cdot f^3$$
 (8)

二、实验装置

图1为x波段等离子体测试系统。

速调管为723A/B型,反射极用锯齿波调制,所 调制的微波信号经过隔离器、可变衰减器、波长计、 方向耦合器,到测试圆柱空腔。方向耦合器把反射 回来的信号输送给晶体检波器,检波的微波信号经 低频放大器放大,由示波器观察。

三、测量结果

我们利用微波谐振腔测量了 CO2 激光器、CO 激光器及各种纯气体放电中的电子密度和电子密度 随气压、气体组分、放电电流及 E/P 值变化的关系 曲线。

. 58 .



图1 微波腔测量气体激光器电子密度实验装置 1-速调管;2-隔离器;3-可变衰减器;4-波 长计;5-方向耦合器;6-圆柱空腔;7-晶体 检波器;8-放大器;9-示波器;10-速调管调 制电源;11-激光器

1. N₂ 气和 He 气对 CO₂ 激光器电子密度的影 响(见图 2)。



从图 2 中可以看出,在 2 托纯 CO₂ 中加入 1 托 N₂ 气后,电子密度略有下降,而后,随着 N₂ 气量的 增加,电子密度稍有上升。

在 CO₂:N₂ 为 1:1, 总压 3 托的混合 气体中逐渐加入 He 气后,在 He 气量较少时电子密度几乎不变。随着 He 气量增加到总压为 10 托以后,即 He 的含量是 CO₂ 的 4.5 倍以后,电子密度随 He 气压的增加变大,由 3.3×10^{10} /厘米³增加到 4.8×10^{10} /厘米³。

2. Xe 气对 CO₂ 激光器电子密度的影响 (见 图 3)

从图3可以看出,在(1托CO₂+1托N₂+8托 He)的混合气体中加入Xe气后,使电子密度大幅 度增加,由 3.7×10¹⁰/厘米³增加到5.9×10¹⁰/厘 米³,增加了60%。

3. He 气和 Xe 气对 CO 激光器电子密度的影





响(分别见图4、图5)

从图 4 中可以看出,在(0.6 托 CO+1.2 托 Xe) 的混合气体中加入 He 气后,使电子密度增加较快, 由 0.7×10¹⁰/厘米³ 增加到 3.4×10¹⁰/厘米³。

从图 5 中可以看出,在 13 托(CO₂+He)的混合 气体中加入 Xe 气后,也使电子密度增加,由1.3× 10^{ro}/厘米³增加到 3.8×10^{fo}/厘米³。

· 59 ·

加入 He 气和 Xe 气,均能提高 CO 激光器中的 电子密度,这一特性与 He 气和 Xe 气对 CO2激光器 的作用是一致的。只不过 He 气和 Xe 气对 CO 激 光器电子密度的影响,比它们对 CO2 激光器电子密 度的影响要大。

4. 放电电流对 CO2激光器, CO激光器及纯 CO2、N2、He 气放电中电子密度的影响(见图 6)



 图 6 放电电流对 CO₂ 激光器、CO 激光器和对 CO₂、N₂、He 放电中电子密度的影响
P=8.5托(□-CO₂; ×-N₂; △-He; O-CO₂:N₂:He=1:1:8); P=15托 (●-CO:Xe:He=1:2:20)

从图 6 中可以看出, 在相同的气压下, 不论对于 CO₂ 激光器、CO 激光器, 还是对于纯 CO₂、N₂、He 放电, 电子密度均随着放电电流的增加而线性增加。 但在相同放电电流下, 纯 He 放电具 有 较高 的 电子 密度, 而在 N₂ 放电中电子密度最低。

5. *E/P* 值对 CO₂ 激光器、CO 激光器及纯 CO₂、N₂放电中电子密度的影响(见图7)。

从图7中可以看出,在放电电流保持不变的条



图 7 E/P 值对 CO2 激光器、CO 激光器、CO2、N2 放电中电子密度的影响
△-N2;×-CO2; ○-CO: ×e:He=1:2:20; □-CO2:N2:He=1:1:8; I-15 毫安

件下,电子密度随 *E*/*P* 值的增加而减少,这是因为 电流密度可以写成:

$j = n_e e v_d$

n。是电子密度; va 是电子的漂移速度。从式中可以 看出,在电流密度恒定时, n。反比于 va, 而电子的漂 移速度又与 E/P 值成正比。所以在放电电流不变 时,电子密度与 E/P 值有反比关系。

参考文献

- [1] P. F. Sland; Phys. Rev., 1951, 84, p. 559.
- [2] L. Gould, S. C. Brown; Phys. Rev., 1954, 95, 897.
- [3] J. M. Anderson; Phys. Rev., 1956, 102, 933.
- [4] A. L. Gilardini; Phys. Rev., 1957, 105, 25.
- [5] S J. Buchsbaum; Phys. Fluids, 1960, 3, 806.
- [6] 卢鹤跋等; 《受控热核反应》, 上海科学技术出版社 出版, 1962 年。

(中国科学院上海光机所 王玉芝 谢培良 董景星 1980年9月17日收稿)